

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при температуре $(25 \pm 5)^\circ \text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Ток утечки аналогового входа, нА, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$; $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$	I_{LS}	-	50
Ток утечки аналогового выхода, нА, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$; $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$	I_{LD}	-	70
Ток потребления при низком уровне управляющего напряжения, мкА, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$ по выводам 3, 13	I_{CCL}	-	15
Ток потребления при высоком уровне управляющего напряжения, мкА, при: $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ по выводу 13 по выводу 3	I_{CCH}	-	1000 15
Входной ток низкого уровня управляющего напряжения, мкА, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$	I_{IL}	-	0,2
Входной ток высокого уровня управляющего напряжения, мкА, при: $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$	I_{IH}	-	0,2
Время включения, нс, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$; $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$; $R_{\text{T}} = 10 \text{ кОм}$; $C_{\text{L}} = 40 \text{ пФ}$	t_{ON}	-	300
Сопротивление в открытом состоянии, Ом, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$; $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$; $I_{\text{S}} = 1 \text{ мА}$	R_{ON}	-	300

Остальной режим измерения при: $U_{\text{CC1}} = \text{от } 13,5 \text{ В до } 16,5 \text{ В}$;
 $U_{\text{CC2}} = \text{от минус } 16,5 \text{ В до минус } 13,5 \text{ В}$;

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

- золото
- серебро

Цветных металлов не содержится.

НАДЕЖНОСТЬ

Наработка микросхем до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых настоящими ТУ, при температуре окружающей среды не более $(65+5)^\circ \text{C}$, должна быть не менее 100000 ч. и не менее 120000 ч. в следующем облегченном режиме: коммутируемое напряжение не более 5 В и не менее минус 5 В, отклонение напряжений питания от номинальных значений $\pm 5\%$.

Гамма-процентный срок сохраняемости ($T_{\text{сγ}}$) микросхем при $\gamma = 99\%$.

Минимальный срок сохраняемости микросхем ($T_{\text{см}}$)

при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕНВ.431160.636-05 ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.